

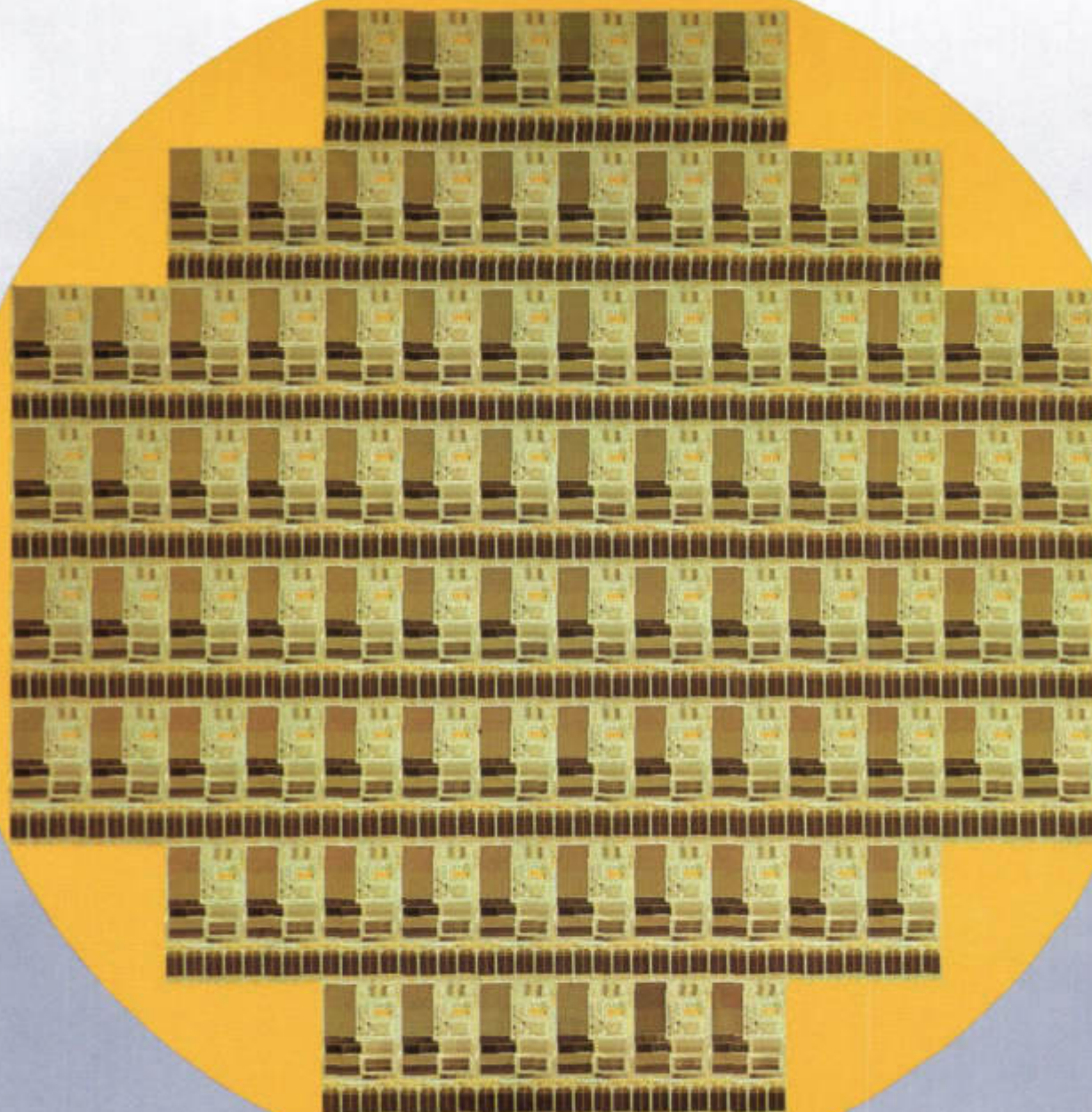


ZEISS

U 6548 DC

Mikro-
elektronische
Bauelemente

Statischer Speicher



U 6548 DC

**Schneller statischer Schreib-/Lese-Speicher
mit wahlfreiem Zugriff (SRAM)
U 6548 DC 20 und U 6548 DG 20**

Kurzcharakteristik

- Organisation 1024 x 4 Bit
- Zugriffszeit (ns) 20
- Zykluszeit (ns) 30
- Betriebsspannung +5 V/± 10%
- Geringe Stromaufnahme 50 µA (Ruhestromverbrauch)
- Gemeinsame (bidirektionale) Datenein-/ausgänge
- Tristate-Ausgangsstufen
- 18poliges DIL-Gehäuse
- Adreßwischenspeicherung
- Datenerhaltung bis $U_{CC} = 2$ V
- CMOS-Silizium-Gate-Technologie
- Pin kompatibel zum U 224

Technische Daten

Grenzwerte

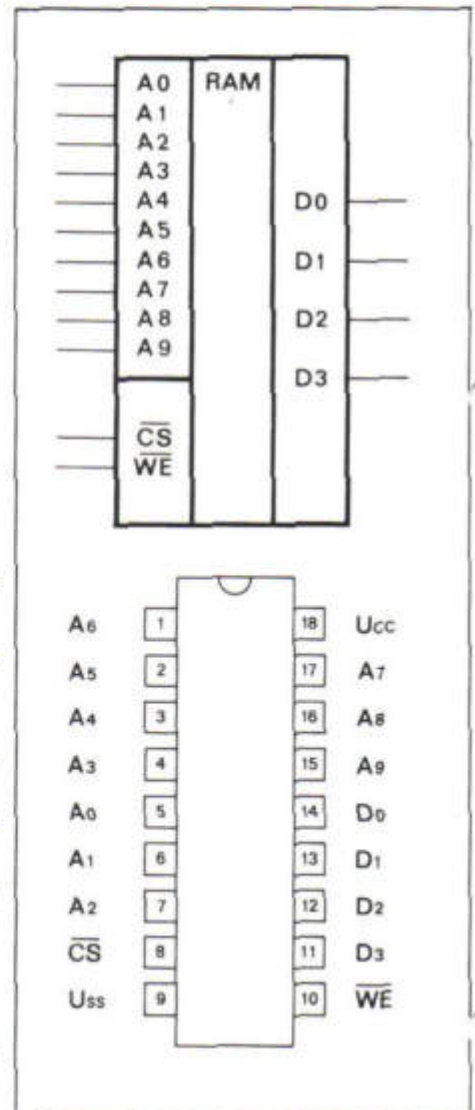
Alle Spannungen sind auf $U_{SS} = 0$ V bezogen.

Kenngröße	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Spannung in allen Pins	U_{SR}	-0,5	7	V
Verlustleistung	P_V		0,5	W
Lagertemperatur	ϑ_s	-55	125	°C

Betriebsbedingungen

Kenngröße	Kurzzeichen	U6548 DG 20 min.	U6548 DG 20 max.	U6548 DC 20 min.	U6548 DC 20 max.	Einheit
Betriebsspannung	U_{CC}	4,5	5,5	4,5	5,5	V
Schlafspannung	U_{CCS}	2		2		V
Eingangs-Low-Spannung	U_{IL}	-0,3	0,8	-0,3	0,8	V (1)
Eingangs-High-Spannung	U_{IH}	$U_{CC}-2$	$U_{CC}+0,5$	$U_{CC}-2$	$U_{CC}+0,5$	V
Umgebungstemperatur	ϑ_a	-25	85	0	70	°C

(1) Eine einmalige Unterschreitung bis -2 V für die Dauer von 10 ns innerhalb der Zykluszeit ist zulässig.



Anschlußbelegung und Schaltzeichen

(Markierung kennzeichnet Seite mit PIN 1)

A0...A9	Adreßeingänge
$\overline{CS}$	Chipauswahl
WE	Lese-/Schreibsteuerung
D0...D3	Datenein-/ausgänge
U_{CC}	Betriebsspannung
U_{SS}	Masse



VEB Forschungszentrum
Mikroelektronik Dresden
Betrieb des Kombirates
VEB Carl Zeiss JENA
Carl-Zeiss-Str.1
Jena
DDR-6900